



56Gbaud InGaAs PIN 1×4 Array PD Chip $\phi 16\mu\text{m}$ (500um Pitch)



产品描述

InGaAs PIN 高速光探测器阵列芯片

产品特点

数据速率高达 100-400Gbps； $\phi 16\mu\text{m}$ 有效面积；高响应度；GSG 电极结构

应用领域

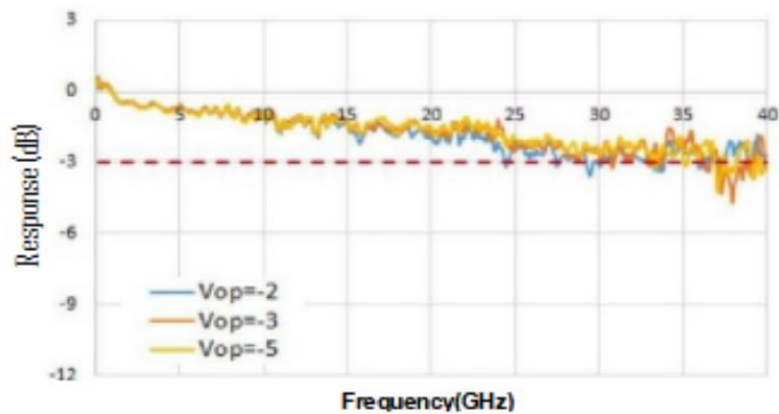
IEEE 400/800Gbps Ethernet | 200G CWD4、PSM4、LR4 | 长途光纤网络 | 光纤数据通信

核心参数

无
无



详细参数



规格 (Tc=25°C, 单颗裸芯片)

参数	符号	最小值	典型值	最大值	单位	测试条件
响应范围	λ	900		1650	nm	
响应度	R	0.8	0.9		A/W	$\lambda=1310-1550\text{nm}$
暗电流	I_D		0.02	1	nA	$V_R=-5\text{V}$
电容	C		0.05		pF	$V_R=-2\text{V}, f=1\text{MHz}$
带宽	Bw		36		GHz	$V_R=-2\text{V}$ 3dB down, RL=50Ω
有效区直径	D		16		um	
通道之间的中心间距 (pitch)			750/500/250		um	